15

범용원소 이용 초저가 무기 박막태양전지

요 연구책임자 신재생에너지연구소

문의

C TEL

🔀 E-mail

한국에너지기술연구원

기술사업화실

042-860-3384

kier-tlo@kier.re.kr

태양광연구실 곽지혜

태양전지의 제조비용 절감에 용이한 범용원소로 이루어진 칼코제나이드 반도체를 광흡수층으로 사용하고, 이를 양산화에 적합한 공정으로 박막을 형성하는 기술.

○ 기술의 구성도/개념도



○ 기술의 주요 내용 및 특징

- · 범용원소기반 Cu₂ZnSn(S,Se)₄ 화합물 박막을 1-2 µm의 균일한 두께로 10x10 cm² 대면적 증착가능
- 상기 화합물 박막의 증착 공정온도를 <500℃이하에서 고품질로 성막가능
- S/Se 원소비 제어를 통한 에너지밴드갭 제어가 가능하여 단일접합 혹은 다층접합 태양전지의 상부 혹은 하부태양전지로 적용가능
- 기존 유리 기판 뿐만 아니라 유연한 기판소재를 이용하여 유연 박막태양전지 구현 가능

○ 기술의 적용처

응용분야 태양광 발전소, 가정용 태양광 모듈, 이동전원

건물일체형 태양광모듈 / 자동차일체형 태양광모듈 / 이동 전원 / 일반 태양광 모듈 제품

적용제품





○ 기술의

성숙도

○ 지식재산권

현황



			_	•	
	1	2		3	
1	기초	여구	1		시허

기존 기술

순번 발명의 명칭 이중의 밴드갭 기울기가 형성된 CZTS계 박막의 제조 방법 동시진공증발공정 기반의 CZTSe 2 광흡수층 제조방법 태양전지용 칼코겐 화합물 광흡수층 3 박막 형성 방법

	본 기술
n, Ga 낮고, '성이 큼	 태양전지의 광흡수층으로 범용원소기반인 Cu,ZnSn(S,Se), 화합물 박막을 동시증발법에 의한 one-step으로 낮은 공정온도 조건에서 증착 가능함





	출원번호	출원일자	등록번호	등록일자
	(한국) 10-2012-0066111	2012.06.20	10-1339874	2013.12.04
	(미국) 14/364,879	2014.06.12	9,780,246	2017.10.03
	(한국) 10-2013-0042782	2013.04.18	10-1406704	2014.06.02
	(중국) 201480021343.3	2015.10.15	ZL2014 80021343,3	2017.12.08
	(한국) 10-2015-0159160	2015.11.12	10-1723096	2017.03.29
	(미국) US 15/209,837	2016.07.14	10/056,512	2018.08.21





15

Principal researcher

Photovoltaics Laboratory of the New and Renewable Energy Institute

Gwak Ji-Hye

Ultra-low-cost Inorganic Thin-film Solar Cells Using earth-abundant **Elements**

Thin-film technology to produce high-quality photovoltaic absorbers using low-cost and earth-abundant chalcogenide compounds through processes suitable for mass production.

Structural Diagram/Conceptual Diagram



Description and Characteristics of Technology

Scope of Application

- Capable of depositing an earth-abundant element-based Cu₂ZnSn(S,Se)₄ compound thin film with a uniform thickness of 1-2 µm and large area of 10x10 cm²
- Capable of depositing a thin film of Cu2ZnSn(S,Se)4 compound with high quality at the temperature of 500°C or below
- Applicable to the top or bottom cells of single-junction or multi-junction solar cells because the energy bandgap can be adjusted by controlling the S/Se atomic ratio
- Applicable to rigid glass substrates as well as flexible substrates to realize flexible thin-film solar cells

O Inquiries

Business Development Team of the Korea Institute of Energy Research

📞 Tel 042-860-3384

E-mail kier-tlo@kier.re.kr





O Comparative advantages of technology / Differentiation from existing technologies

• Experimental and empirical data



Samples		Voc (V)	FF (%)	J∝ (mA/cm ²)	E
#577	Without post- annealing	0.33	58.99	33.99	
#594-2	Post-selenization	0.43	60.92	29.18	
#273-3	Post-sulfurization	0.57	52.94	18.14	
					-

complexity.

Maturity level of technology



[TRL 3: Lab-scale basic performance verification]

• Current status of intellectual property rights

Title of Invention No. Method for manufacturing CZTS based thin film having dual band gap slope Method for manufacturing CZTSe light absorbing layer on basis of simultaneous 2 vacuum evaporation process

Method for manufacturing chalcogen 3 compound-based light absorbing layer thin films for solar cells

Conventional Technology

• Cu(In,Ga)Se₂ solar cells can yield a high power conversion efficiency more than 20% but cost competitiveness is low due to the use of scarce elements such as In and Ga and its multistage deposition process is able to add to the

Present Technology

 Earth-abundant element-based Cu₂ZnSn(S,Se)₄ compound thin films, which serve as the light absorbers of solar cells, can be deposited at a low process temperature through an evaporation method with one-step process.

	Application Number	Application Date	Registration Number	Registration Date
	(Republic of Korea) 10-2012-0066111	2012.06.20	10-1339874	2013.12.04
	(USA) 14/364,879	2014.06.12	9,780,246	2017.10.03
	(Republic of Korea) 10-2013-0042782	2013.04.18	10-1406704	2014.06.02
	(China) 201480021343.3	2015.10.15	ZL2014 80021343.3	2017.12.08
	(Republic of Korea) 10-2015-0159160	2015.11.12	10-1723096	2017.03.29
	(USA) US 15/209,837	2016.07.14	10/056,512	2018.08.21

38 39